3

原本 (出願用) - 印刷日時 2003年12月09日 (09.12.2003) 火曜日 14時22分46秒 $\overline{0}$ 受理官庁記入欄 0-1 国際出願番号 12, 03 0-2 国際出願日 (受付印) 0-4 様式-PCT/RO/101 の特許協力条約に基づく国際 出願願書は、 0-4-1 右記によって作成された。 PCT-EASY Version 2.92 (updated 01.11.2003) 0-5 申立て 出願人は、この国際出願が特許 協力条約に従って処理されるこ とを請求する。 0-6 出願人によって指定された受理 日本国特許庁(RO/JP) 0-7 出願人又は代理人の書類記号 S03P1463W000 ī 色素増感型光電変換装置およびその製造方法 発明の名称 Π 出願人 II-1 この欄に記載した者は 出願人である(applicant only) II-2 右の指定国についての出願人で 米国を除くすべての指定国 (all designated States ある。 except US) II-4 ja 名称 ソニー株式会社 II-4en SONY CORPORATION Name II-5 ia あて名: 141-0001 日本国 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 II-5en 7-35. Kitashinagawa 6-chome. Address: Shinagawa-ku. Tokyo 141-0001 Japan II-6 日本国 JP 国籍(国名) II-7 住所 (国名) 日本国 JP 03-5448-2111 II-8 電話番号 11-9 ファクシミリ番号 03-5448-5709 III-1 その他の出願人又は発明者 III-1-1 この欄に記載した者は 出願人及び発明者である(applicant and inventor) III-1-2 右の指定国についての出願人で 米国のみ (US only) ある。 氏名(姓名) III-1-4j 戸木田 裕一 III-1-4e Name (LAST, First) TOKITA, Yuichi 141-0001 日本国 III-1-5j あて名: 東京都 品川区 北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 III-1-5e Address: C/O SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 Japan III-1-6 国籍 (国名) 日本国 JP III-1-7 住所 (国名) 日本国 JP

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2003年12月09日 (09.12.2003) 火曜日 14時22分46秒

III-2	その他の出願人又は発明者	
111-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-2-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ(US only)
III-2-4j	氏名(姓名)	。 一鈴木 祐輔
a III-2-4e	Name (LAST, First)	SUZUKI, Yusuke
n III-2-5j	あて名:	141-0001 日本国
а		東京都 品川区
		北品川6丁目7番35号
		ソニー株式会社内
III-2-5e n	Address:	C/O_SONY_CORPORATION
		7-35, Kitashinagawa 6-chome,
		Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 Japan
111-2-6	 国籍(国名)	日本国 JP
III-2-7	住所(国名)	日本国 JP
III-3	その他の出願人又は発明者	HT U
111-3-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-3-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ (US only)
III-3-4j	ある。 氏名(姓名)	学 国 工姓
а		諸岡 正浩
n	Name (LAST, First)	MOROOKA, Masahiro
III-3-5j a	あて名:	141-0001 日本国
		東京都 品川区 北品川6丁目7番35号
	·	ソニー株式会社内
III-3-5e	Address:	C/O SONY CORPORATION
n .		7-35, Kitashinagawa 6-chome,
	·	Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Japan
III-3-6 III-3-7	国籍(国名)	日本国 リ
III-4	住所(国名) その他の出願人又は発明者	日本国 JP
III-4-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
III-4-2	右の指定国についての出願人で	米国のみ(US only)
	ある。	
III-4-4j a	氏名(姓名)	石橋 賢一
	Name (LAST, First)	ISHIBASHI, Kenichi
III-4-5j a	あて名:	141-0001 日本国
	·	東京都品川区
		北品川6丁目7番35号
III-4-5e	Address:	ソニー株式会社内 C/O SONY CORPORATION
n	Address.	C/O SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome,
i		Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001
		Japan
III-4-6	国籍 (国名)	日本国 JP
III-4-7	住所(国名)	日本国 JP

特許協力条約に基づく国際出願顧書 原本(出願用) - 印刷日時 2003年12月09日 (09.12.2003) 火曜日 14時22分46秒

III-5	その他の出願人又は発明者	
III-5-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-5-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ(US only)
[[[-5-4]	める。 氏名(姓名)	野田 和宏
a III-5-4e	Name (LAST, First)	NODA, Kazuhiro
n 111-5-5j	i	141-0001 日本国
a		東京都品川区
III-5-5e n	Address:	北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 C/O SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0001 Japan
111-5-6	国籍 (国名)	日本国 JP
111-5-7	住所 (国名)	日本国 JP
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知	
	のあて名 下記の者は国際機関において右 記のごとく出願人のために行動 する。	代理人(agent)
[V-1-1ja	「 氏名(姓名)	杉浦 正知
IV-1-len	Name (LAST, First)	SUGIURA, Masatomo
IV-1-2ja	あて名:	171-0022 日本国
		東京都 豊島区 南池袋 2丁目49番 7号
		南池袋 2丁目49番 2号
IV-1-2en	Address:	池袋パークビルフ階 7th Floor, Ikebukuro Park Bldg., 49-7, Minami Ikebukuro 2-chome,
		Toshima-ku, Tokyo 171-0022 Japan
IV-1-3	電話番号	03-3980-0339
IV-1-4	ファクシミリ番号	03-3982-3166
IV-1-5	電子メール	sugipat2@mbc.nifty.com
TV-2	その他の代理人	筆頭代理人と同じあて名を有する代理人 (additional agent(s) with same address as first named agent)
[V-2-1ja	氏名	森幸一
IV-2-1en	Name(s)	MORI, Koh-ichi
٧	国の指定	
V-1	広域特許	AP: BW GH GM KE LS MW MZ SD SL SZ TZ UG ZM ZW
	(他の種類の保護又は取扱いを 求める場合には括弧内に記載す	及びハラレプロトコルと特許協力条約の締約国である
	る。)	他の国
		EA: AM AZ BY KG KZ MD RU TJ TM 及びユーラシア特許条約と特許協力条約の締約国であ
	•	及びユーブング特許条約と特許協力条約の締が国でめ る他の国
		EP: AT BE BG CH&LI CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
		GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE SI SK TR
		及びヨーロッパ特許条約と特許協力条約の締約国であ
		る他の国
		OA BF BJ CF CG CI CM GA GN GQ GW ML MR NE SN
		TD TG 及びアフリカ知的所有権機構と特許協力条約の締約国 である他の国
	L	

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本(出願用) - 印刷日時 2003年12月09日 (09.12.2003) 火曜日 14時22分46秒

S03P1463W000

V-2	国内特許 (他の種類の保護又は取扱いを 求める場合には括弧内に記載す る。)	NO	LI GD LK	AL CN GE LR OM TN	AM CO GH LS PG TR		HR LU PL	LV	DE ID MA RO	DK IL MD RU	BG DM IN MG SC UZ	DZ IS MK SD	EC KE MN SE	EE KG MW SG	EG KP MX SK	KR MZ SL	FI KZ
V-5	指定の確認の宣言	-															
	出願人は、上記の指定に加えて、規則4.9(b)の規定に基づき、特許協力条約のもとで認められる他の全ての関の指定を見ります。														٠		
	ただし、V-6欄に示した国の指定を除く。出願人は、これらの追加される指定が確認を条件としていること、並びに優先日から15月が経過する前にその確認											•					
	がなされない指定は、この期間 の経過時に、出願人によって取 り下げられたものとみなされる ことを宣言する。																
V-6	指定の確認から除かれる国	なし	<u>, (</u>	<u>NON</u>	IE)			_									· · ·
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主																
VI-1-1	張 出願日	200	2年	191	3 25		(25	12	20	ากวา							
VI-1-2	出願番号	特原						, 12	20	,OZ,							
VI-1-3	国名	日本				101											
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本				(1	SA/	JP)									
VIII	申立て				申立												
1-111V	発明者の特定に関する申立て	_			-												
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格 に関する申立て	-															
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格 に関する申立て	-															
VIII-4	発明者である旨の申立て (米国 を指定国とする場合)	-															
F-IIIA	不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て	-												,			
IX	照合欄			月	月紙の	枚数					羽	続付き	れた	電子:	デーク	7	
IX-1	願書(申立てを含む)	5								_							
IX-2	明細書	17								-							
1X-3	請求の範囲	2								_							
IX-4	要約	1								EZA	BST	00.	TXT				
IX-5	図面	3								_							
IX-7	合計	28															

特許協力条約に基づく国際出願願書 原本 (出願用) - 印刷日時 2003年12月09日 (09.12,2003) 火曜日 14時22分46秒

S03P1463W000

所紙 大の原本 つ写し うに提示する図の番 を用言語名: を押印	✓ ✓ 優先権証明書 VI- - 納付する手数料に 特許印紙を貼付し 国際事務局の口座 込みを証明する書 1 日本語 杉浦 正知 森 幸一 受理官庁記入欄	フレキシ 相当する - た書面 への振り -	フ・ルテ・ィスク	
大の原本)写し (スク)に提示する図の番 使用言語名: 近押印	▼ 優先権証明書 VI- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1 - フルギン 相当する - た書面 - への振り - 面 でででは、 でででは、 ででででは、 ででででは、 でででできる。 ででででは、 ででできる。 ででででは、 ででできる。 ででできる。 でででできる。 でででできる。 ででできる。 でででできる。 でででできる。 でででできる。 でででできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 でででき。 ででできる。 ででできる。 ででででき。 でででででき。 ででででき。 ででででき。 ででででき。 ででででき。 ででででき。 ででででき。 ででででき。 ででででき。 ででででき。 ででででき。 ででででででき。 でででででででで	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゙゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙゚゚゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゚゚゙゚	
手 (スク っに提示する図の番 使用言語名: 3.押印	- 納付する手数料に 特許印紙を貼付し 国際事務局の口座 込みを証明する書 1 日本語 杉浦 正知	フルギシ 相当する - た書面 - への振り - 面 - でででできる。 でででできる。 でできる。 とでできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でできる。 ででできる。 でででできる。 ででできる。 でででき。 とでできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 とででででででででき。 とでででできる。 でででででででででででででででででででででででででででででででで	プ ルデ イスク	
手 (スク っに提示する図の番 使用言語名: 3.押印	- 納付する手数料に 特許印紙を貼付し 国際事務局の口座 込みを証明する書 1 日本語 杉浦 正知	フルギシ 相当する - た書面 - への振り - 面 - でででできる。 でででできる。 でできる。 とでできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でできる。 ででできる。 でででできる。 ででできる。 でででき。 とでできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 とででででででででき。 とでででできる。 でででででででででででででででででででででででででででででででで	プルディスク	
(スク)に提示する図の番 使用言語名: 3.押印	- 納付する手数料に 特許印紙を貼付し 国際事務局の口座 込みを証明する書 1 日本語 杉浦 正知	フルギシ 相当する - た書面 - への振り - 面 - でででできる。 でででできる。 でできる。 とでできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でできる。 でできる。 ででできる。 でででできる。 ででできる。 でででき。 とでできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 ででできる。 とででででででででき。 とでででできる。 でででででででででででででででででででででででででででででででで	ブルディスク	
使用言語名: 区押印	特許印紙を貼付し 国際事務局の口座 込みを証明する書 1 日本語 杉浦 正知	た書面		
使用言語名: 区押印	国際事務局の口座 込みを証明する書 1 日本語 杉浦 正知 森 幸一	への振り一面 に影響		
使用言語名: 区押印	杉浦 正知森 幸一	東理		
3押印	杉浦 正知森 幸一	東理		
	森 幸一	東理		
3押印	森 幸一	東理		
3押印		東理		
-		心言	<u> </u>	
	受理官庁記入欄			
	文字百万 記入 (18			•
ンて提出された書類 里の日				
§類又は図面であっ 引内に提出されたも				
宅の期間内の受理の				
•				
k払いにつき、国際 関査用写しを送付し				
	国際事務局記入欄			
		the state of the s		
	のる して提出された書類 書類又は図面であたも 別内に提出された日) 受理の日(訂正日) 内第11条(2)に基づ 元の期間内の受理の り特定された国際調	りる して提出された書類 書類又は図面であっ 引内に提出されたも 受理の日(訂正日) 内第11条(2)に基づ 完の期間内の受理の り特定された国際調 ISA/JP 長払いにつき、国際 関査用写しを送付し	50 して提出された書類 書類又は図面であっ 調内に提出されたも 受理の日(訂正日) 内第11条(2)に基づ 完の期間内の受理の の特定された国際調 「SA/JP E払いにつき、国際 調査用写しを送付し	50 して提出された書類 書類又は図面であっ 調内に提出されたも 受理の日(訂正日) 内第11条(2)に基づ 完の期間内の受理の の特定された国際調 ISA/JP E払いにつき、国際 調査用写しを送付し

明 細 書

色素増感型光電変換装置およびその製造方法

5 技術分野

この発明は、色素増感型光電変換装置およびその製造方法に関し、 特に、色素増感型太陽電池に適用して好適なものである。

背景技術

20

25

- 10 従来、化石燃料に代わるエネルギー源として、太陽光を利用する様々な太陽電池が開発されている。これまで最も広く用いられている太陽電池はシリコンを用いたもので、多数市販されている。これらは大別して、単結晶または多結晶のシリコンを用いた結晶シリコン系太陽電池と、非晶質(アモルファス)シリコン系太陽電池とに分けられる。
- 15 従来、太陽電池には、単結晶または多結晶のシリコン、すなわち結 晶シリコンが多く用いられてきた。

しかしながら、この結晶シリコン系太陽電池では、光(太陽)エネルギーを電気エネルギーに変換する性能を表す光電変換効率が、アモルファスシリコン系太陽電池に比べて高いものの、結晶成長に多くのエネルギーと時間とを要するため生産性が低く、コスト面で不利であった。

また、アモルファスシリコン系太陽電池は、結晶シリコン系太陽電池と比べて光吸収性が高く、基板の選択範囲が広い、大面積化が容易である等の特徴があるが、光電変換効率が結晶シリコン系太陽電池より低い。さらに、アモルファスシリコン系太陽電池は、生産性は結晶シリコン系太陽電池に比べて高いが、製造に真空プロセスが必要であ

り、エネルギー負担は未だに大きい。

10

15

20

25

また、これらの太陽電池は、ガリウム、砒素、シランガス等の毒性 の高い材料を使用することから、環境汚染の面でも問題がある。

その中で、Nature Vol. 353, p. 737, 1991で発表された色素増感型太陽電池は、現在までに10%という高い光電変換効率が実現可能であることが示されており、かつ、安価に製造することができると考えられることから注目されている。この色素増感型太陽電池は、増感色素にルテニウム錯体を用いて分光増感した多孔質チタニア(酸化チタン、TiO2)膜を光電極(半導体電極とも称される)とする湿式太陽電池、すなわち電気化学光電池である。

なお、近年、特殊なナノメートルサイズのチューブ状のチタニアが春日らによって開発されている(特開平10-152323号公報、特開2002-241129号公報)。また、カーボンナノチューブに代表されるナノメートルサイズの空孔内は、特殊なポテンシャル場を有しており、強い吸着エネルギーを有することが知られている(Journal of the Society of Inorganic Materials, Japn 8,418-427(2001))。

しかしながら、上述の従来の色素増感型太陽電池に用いられる増感 色素は、多孔質チタニアに吸着させて使用することから、カルボン酸 等の酸性置換基を有する必要があり、これが使用することのできる増 感色素の種類を制限してきた。ここで、増感色素を多孔質チタニアに 担持させるのに酸性置換基が必要な理由は、多孔質チタニアの表面の 吸着エネルギーが増感色素を吸着させるには弱いことから、増感色素 に静電相互作用を付与しなければならないためである。

また、酸性置換基を増感色素に導入するため、増感色素の製造コストが高く、ひいては色素増感型太陽電池の製造コストが高くならざるを得なかった。

さらに、酸性置換基を増感色素に導入すると、その酸性置換基を介 した増感色素同士の会合が起きやすくなって光励起電子の分子間消光 現象が発生し、これが半導体層への励起電子の注入効率の低下をもた らし、増感色素の導入による光電変換効率の向上の効果を十分に得る ことができなかった。

10 このように、従来の色素増感型太陽電池では、増感色素が酸性置換基を有するため、使用することのできる増感色素の種類が制限されるだけでなく、増感色素の製造が煩雑であることにより製造コストが高く、光電変換効率の向上も制限されていたため、実用化が困難であるという課題を有していた。

15 従って、この発明が解決しようとする課題は、任意の増感色素を使用することができ、製造コストが安価でしかも光電変換効率が高い色素増感型光電変換装置およびその製造方法を提供することである。

発明の開示

20 本発明者らは、従来技術が有する上記の課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、増感色素として酸性置換基を有さないものの使用を可能とするためには、半導体層にチタニアナノチューブを用いることが最も有効であることを見出し、この発明を案出するに至ったものである。

25 すなわち、上記課題を解決するために、この発明は、 チタニアナノチューブを含む半導体層と、 そのチタニアナノチューブに担持された増感色素と、を有する ことを特徴とする色素増感型光電変換装置である。 この発明はまた、

チタニアナノチューブを含む半導体層を用い、

10

15

20

25

5 そのチタニアナノチューブに増感色素を担持させるようにした ことを特徴とする色素増感型光電変換装置の製造方法である。

この発明において、チタニアナノチューブに担持させる増感色素としては、増感作用を示すものであれば特に制限はなく、酸性置換基の有無を問わない。具体的には、増感色素の種類として、例えば、ローダミンB、ローズベンガル、エオシン、エリスロシン等のキサンテン系色素、キノシアニン、クリプトシアニン等のシアニン系色素、フェノサフラニン、カブリブルー、チオシン、メチレンブルー等の塩基性染料、クロロフィル、亜鉛ポルフィリン、マグネシウムポルフィリン等のポルフィリン系化合物、その他アゾ色素、フタロシアニン化合物、クマリン系化合物、Ruビピリジン錯化合物、アントラキノン系色素、多環キノン系色素等が挙げられる。この中でも、ルテニウム(Ru)ビピリジン錯化合物は量子収率が高く特に好ましいが、これに限定されるものではなく、単独もしくは2種類以上混合して用いることができる。また、これらの増感色素に酸性基を付けたものを用いてもよい。

例えば上記増感色素をアルコール類、ニトリル類、ニトロメタン、ハロゲン化炭化水素、エーテル類、ジメチルスルホキシド、アミド類、Nーメチルピロリドン、1,3ージメチルイミダゾリジノン、3ーメチルオキサゾリジノン、エステル類、炭酸エステル類、ケトン類、炭化水素、水等の溶媒に溶解させ、これにチタニアナノチューブを浸漬し、もしくは、色素溶液をチタニアナノチューブを含む半導体層に塗

増感色素のチタニアナノチューブへの担持方法に特に制限は無く、

布する方法が一般的である。また、増感色素分子がチタニアナノチューブに対して大幅に過剰に担持された場合、光エネルギーによって励起された電子がチタニアナノチューブに注入されず、電解質を還元するためエネルギーロスの原因となる。従って、増感色素分子はチタニアナノチューブに対して単分子吸着が理想的な状態であり、必要に応じて担持させる温度や圧力を変化させることが可能である。増感色素同士の会合を低減する目的でデオキシコール酸等のカルボン酸類を添加しても良い。また、紫外線吸収剤を併用することもできる。

過剰に担持された増感色素の除去を促進する目的で、増感色素が担持されたチタニアナノチューブに対し、アミン類を用いて表面を処理しても良い。アミン類の例としてはピリジン、4-tertーブチルピリジン、ポリビニルピリジン等が挙げられ、これらが液体の場合は、そのまま用いても良いし、有機溶媒に溶解して用いても良い。

10

15

20

25

チタニアナノチューブの直径は、増感色素を担持させることが可能である限り特に制限されないが、典型的には5 nm以上80 nm以下である。チタニアナノチューブの結晶型は好適にはアナターゼ型である。

色素増感型光電変換装置においては、一般的に、互いに対向する一対の電極間に、増感色素を担持させたチタニアナノチューブを含む半導体層と電解質層とが設けられる。より具体的には、透明導電性基板とこの透明導電性基板の対極をなす導電性基板との間に半導体層と電解質層とが設けられ、光電変換によって透明導電性基板と導電性基板との間に電気エネルギーを発生する。

透明導電性基板は、導電性または非導電性の透明支持基板上に透明 導電膜を形成したものであっても、全体が導電性の透明基板であって も良い。この透明支持基板の材質は特に制限されず、透明であれば種

々の基材を用いることができる。この透明支持基板は、光電変換装置外部から侵入する水分やガスの遮断性、耐溶剤性、耐候性等に優れているものが好ましく、具体的には、石英、ガラス等の透明無機基板、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリフッ化ビニリデン、テトラアセチルセルース、ブロム化フェノキシ、アラミド類、ポリイミド類、ポリスチレン類、ポリアリレート類、ポリスルフォン類、ポリオレフィン類等の透明プラスチック基板が挙げられるが、これらに限定されるものでは無い。この透明支持基板としては、加工性、軽量性等を考慮すると、透明プラスチック基板を用いるのが好ましい。また、この透明支持基板の厚さは特に制限されず、光の透過率、光電変換装置内部と外部との遮断性等によって自由に選択することができる。

5

10

15

20

25

透明導電性基板の表面抵抗は低いほど好ましい。具体的には、透明導電性基板の表面抵抗は $500\Omega/\square$ 以下が好ましく、 $100\Omega/\square$ がさらに好ましい。透明支持基板上に透明導電膜を形成する場合、その材料としては公知のものを使用可能であり、具体的には、インジウムースズ複合酸化物(ITO)、フッ素ドープITO(FTO)、SnO2、等が挙げられるが、これらに限定されるものではなく、これらを2種類以上組み合わせて用いることができる。また、透明導電性基板の表面抵抗を低減し、集電効率を向上させる目的で、透明導電性基板上に導電性の高い金属の配線をパターニングすることも可能である。

色素増感型光電変換装置は、典型的には、色素増感型太陽電池として構成される。

上述のように構成されたこの発明によれば、チタニアナノチューブ を含む半導体層を用いるために、エタノール等の溶媒に増感色素を溶 かした溶液にこの半導体層を接触させた場合、その増感色素は、毛細管現象によりチタニアナノチューブの内部に速やかに侵入する。その後、溶媒を除去するとチタニアナノチューブ内に増感色素が残り、チューブ内部特有のポテンシャル場により、増感色素はチタニアナノチューブ内に安定に留まることができる。このため、増感色素に特殊な酸性置換基を導入する必要が無い。

また、チタニアナノチューブの比表面積は $270 \,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ と、一般的に色素増感型太陽電池で用いられている多孔質チタニアのアナターゼ結晶の比表面積($50 \,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$)よりも飛躍的に大きくなることから、吸着する増感色素の量も増大し、光電変換効率を大幅に向上させることができる。

また、増感色素に酸性置換基を導入する必要がないことから、増感 色素間の会合を抑えることができ、光励起電子の分子間消光現象を抑 制し、効率よくチタニアナノチューブに励起電子を注入することがで きることからも、光電変換効率を向上させることができる。

さらに、増感色素に酸性置換基を導入する必要がないことから、増 感色素の製造プロセスが簡単になってその製造コストを大きく引き下 げることが可能になるだけでなく、酸性置換基導入の制約が無くなる ことにより、未知の新規な増感色素の導入も容易になり、増感色素の 選択の幅が大きく広がる。

図面の簡単な説明

5

10

15

20

25

第1図は、この発明の一実施形態による色素増感型太陽電池を示す断面図、第2図は、この発明の一実施形態による色素増感型太陽電池の半導体層を構成する増感色素担持チタニアナノチューブを模式的に示す略線図、第3図は、従来の色素増感型太陽電池の半導体層を構成

する増感色素担持多孔質チタニアを模式的に示す略線図である。

発明を実施するための最良の形態

5

10

以下、この発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。この一実施形態による色素増感型光電変換装置においては、増感色素を担持したチタニアナノチューブからなる半導体層が用いられる。このチタニアナノチューブの直径は約5~80nmであり、長さは通常50~150nmである。このチタニアナノチューブの壁厚は通常2~10nmである。また、このチタニアナノチューブの結晶型はアナターゼ型である。

チタニアナノチューブは、例えば公知の方法(特開平10-152323号公報、特開2002-241129号公報)を参考にして、 チタニア粉末をアルカリ処理することにより得ることができる。

アルカリ処理は、通常、水酸化ナトリウム濃度 $13 \sim 65$ w t%、 温度 $18 \sim 180$ $\mathbb C$ の条件下で、 $1 \sim 50$ 時間、チタニア粉末を浸漬して行う。ここで、水酸化ナトリウム濃度が 13 w t %未満ではチューブの形成に時間がかかりすぎ、65 w t %を超えるとチューブ状のものが生成されにくくなる。また、18 $\mathbb C$ より低い温度では生成のための反応時間が長くなり、160 $\mathbb C$ を超えるとチューブ状のものが生 成されにくくなる。このアルカリ処理は、望ましくは、水酸化ナトリウム濃度 $18 \sim 55$ w t%、温度 $50 \sim 120$ $\mathbb C$ の条件下で、さらに望ましくは、水酸化ナトリウム濃度 $30 \sim 50$ w t%、温度 $50 \sim 120$ $\mathbb C$ の条件下で、 $2 \sim 20$ 時間行う。

また、チタニアナノチューブからなる半導体層は、例えば公知の方 25 法(荒川裕則「色素増感太陽電池の最新技術」(シーエムシー)p. 45 -47(2001))を参考にして、エタノール溶液に分散させたチタニアナノ チューブを粘結剤であるポリエチレンオキサイド(PEO)と混合し、 遊星ボールミルで均一化後、この混合物を例えばフッ素ドープ導電性 ガラス基板(シート抵抗 3 0 Ω/□)にスクリーン印刷し、4 5 0 ℃ で焼成することによって作製することができる。

任意の増感色素をチタニアナノチューブからなる半導体層に担持させるには、例えば、増感色素をジメチルホルムアミド等の適当な溶媒に溶解し、この溶液中にチタニアナノチューブからなる半導体層を浸漬し、この半導体層のチタニアチューブ内に色素が十分に含浸されて十分に吸着するまで放置した後、これを取り出して必要に応じて洗浄後、乾燥を施す。

5

10

15

25

チタニアナノチューブからなる半導体層に担持させる増感色素は l 種類でも複数種類でもよい。

この一実施形態による色素増感型光電変換装置においては、透明導電性基板とこの透明導電性基板の対極をなす導電性基板との間に、上記のチタニアナノチューブからなる半導体層と電解質層とが設けられている。そして、透明導電性基板を透過して光が入射したとき、光電変換によって上記の透明導電性基板と対極の導電性基板との間に電気エネルギーを発生することができる。

この一実施形態による色素増感型光電変換装置は、典型的には、色 20 素増感型太陽電池として構成される。第1図はこの色素増感型太陽電 池を示す。

第1図に示すように、この色素増感型湿式太陽電池においては、透明導電性基板1と、この透明導電性基板1の対極をなす導電膜2を有する基板3との間に、増感色素を担持したチタニアナノチューブからなる半導体層4と電解質層5とが設けられており、これらがケース6によって保護されている。透明導電性基板1と導電膜2とは導線で互

いに接続されており、アンメータ7付きの電流回路8が形成されている。

増感色素を担持したチタニアナノチューブからなる半導体層 4 は、例えば、増感色素を担持したチタニアナノチューブがその外壁面で結合したバンドル構造を有する。また、増感色素は、チタニアナノチューブの内部のほか、その外壁面やバンドル構造のチューブ間空隙内部に担持され得る。第2図に、増感色素を担持したチタニアナノチューブを模式的に示す。

5

10

15

20

25

増感色素を担持したチタニアナノチューブからなる半導体層 4 の形状は、特に制約されるものではなく、膜状、板状、柱状、円筒状等の各種の形状であってよい。

透明導電性基板1は、透明導電膜を備えた透明基板であっても、全体が透明性および導電性を備えた基板であってもよい。透明導電膜を備えた透明基板としては、例えば、ガラスやポリエチレンテレフタレート(PET)等のプラスチック基板等の耐熱基板上に、酸化インジウム、酸化錫、酸化錫インジウム等の薄膜を形成したものが用いられ、全体が透明性および導電性を備えた基板としては例えばフッ素ドープした導電性ガラス基板等が用いられる。この透明導電性基板1の厚さは特に限定されるものではないが、通常0.3~5mm程度である。

対極である導電膜2としては、アルミニウム、銀、錫、インジウム等の従来の太陽電池における対極として公知なものを任意に用いることができるが、I。一イオン等の酸化型レドックスイオンの還元反応を促進する触媒能を持った白金、ロジウム、ルテニウム、酸化ルテニウム、カーボン等がより好ましい。これらの金属膜は導電材料表面に物理蒸着または化学蒸着することによって形成するのが好ましい。

半導体層4と導電膜2との間に介挿される電解質層5としては、従

来より太陽電池の電解質層として使用されていたものの中から任意に用いることができる。このようなものとして、例えばヨウ素とヨウ化カリウムとをポリプロピレンカーボネート25重量%と炭酸エチレン75重量%との混合溶媒に溶解させたものが挙げられる。

この色素増感型太陽電池の動作メカニズムは次のとおりである。

5

10

15

20

2.5

透明導電性基板 1 側に太陽光が入射すると、その光エネルギーによって半導体層 4 中のチタニアナノチューブに担持された増感色素が励起され、電子が発生する。上述のように、透明導電性基板 1 と導電膜 2 とは電流回路 8 によって接続されているので、発生した電子は半導体層 4 中のチタニアナノチューブを通じて導電膜 2 へ流れる。これによって、透明導電性基板 1 と導電膜 2 との間から電気エネルギーを取り出すことができる。

上記のような構造を有する色素増感型太陽電池は、透明導電性基板 1側から擬似太陽光(AM(Air Mass)1.5、100mW/cm²)を照射すると、例えば10.0%以上の高い光電変換効率で発電することが可能である。この光電変換効率は、半導体層4の厚さ、半導体層4の状態、増感色素の吸着状態、電解質層5の種類等に左右されるので、これらの最適条件を選ぶことにより、さらに向上させることができる。

この色素増感型太陽電池によれば、チタニアナノチューブからなる 半導体層 4 を用いるため、エタノール等の溶媒に任意の増感色素を溶 かした溶液にこの半導体層 4 を浸漬すると、増感色素は、毛細管現象 によりチタニアナノチューブの内部に速やかに侵入する。その後、溶 媒を除去するとチタニアナノチューブ内に増感色素が残り、チューブ 内部特有のポテンシャル場により、増感色素はチタニアナノチューブ 内に安定に留まることができ、増感色素に特殊な酸性置換基を導入す る必要が無い。

5

10

15

20

また、チタニアナノチューブの比表面積は $270 \,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ と、一般的に色素増感型太陽電池で用いられている多孔質チタニアのアナターゼ結晶の比表面積($50 \,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$)よりも飛躍的に大きくなることから、吸着する増感色素の量も増大し、光電変換効率を大幅に向上させることができる。

また、増感色素に酸性置換基を導入する必要がないことから、増感色素間の会合を抑えることができ、光励起電子の分子間消光現象を抑制し、効率よくチタニアナノチューブに励起電子を注入することができる。すなわち、第2図に示すように、チタニアナノチューブに担持された増感色素は会合することなく、互いに離れた位置に吸着しているため、増感色素に光が入射することにより発生する光励起電子の分子間消光現象が抑制される。比較のために、第3図に、半導体層に多孔質チタニア薄膜を用いた従来の色素増感型太陽電池において、その多孔質チタニア薄膜に増感色素が担持された様子を模式的に示す。第3図に示すように、増感色素同士が会合して集合体を形成していることが分かる。

さらに、増感色素に酸性置換基を導入する必要がないことから、増 感色素の製造プロセスが簡単になり、増感色素の製造コストを大きく 引き下げることが可能になるだけでなく、酸性置換基導入の制約がは ずれたことにより、未知の新規な増感色素の導入も容易になる。

以下、この発明の具体的な実施例について説明するが、この発明は 以下の実施例に限定されるものではない。

実施例

25 特開平 1 0 - 1 5 2 3 2 3 号公報を参考にしてチタニアナノチュー ブの作製を次のように行った。市販の結晶チタニア(平均粒径: 2 0 nm、比表面積:50m²/g)を40wt%の水酸化ナトリウム水溶液に浸漬し、密閉容器で110℃で20時間反応させた。

次に、荒川裕則「色素増感太陽電池の最新技術」(シーエムシー)p. 45-47(2001)を参考にしてチタニアナノチューブペーストの作製を次のように行った。チタニアナノチューブの含有量が11wt%になるようにしてエタノール溶液に分散させ、この溶液に分子量が50万のPEOを添加し、遊星ボールミルで均一に混合し、増粘したチタニアナノチューブペーストを得た。

5

15

20

得られたチタニアナノチューブペーストをスクリーン印刷法でフッ 素ドープ導電性ガラス基板(シート抵抗 3 0 Ω/□)上に1 c m×1 c mの大きさで塗布した後、4 5 0 ℃に 3 0 分間保持し、チタニアナ ノチューブペーストを導電性ガラス基板上で焼結し、チタニアナノチ ューブ膜を形成した。

そして、酸性置換基を持たない色素として 5 , 1 0 , 1 5 , 2 0 - テトラフェニルポルフィリン亜鉛錯体(ZnTPP)を 5 × 1 0 ⁻⁴ M でジメチルホルムアミドに溶解して調製した溶液中に、上記のチタニアナノチューブ膜を浸漬し、 8 0 ℃において 1 2 時間放置した後、アルゴン雰囲気下でメタノール洗浄し、乾燥した。同様に、酸性置換基を持たない色素としてシスービス(2 , 2 'ービピリジン)ージシアネートルテニウム(N)をそれぞれ 5 × 1 0 ⁻¹ M でジメチルホルムアミドに溶解して調製した溶液中に、上記のチタニアナノチューブ膜を浸漬し、 8 0 ℃において 1 2 時間放置した後、アルゴン雰囲気下でメタノール洗浄し、乾燥した。

 ニアナノチューブ膜を浸漬し、80℃において12時間放置した後、アルゴン雰囲気下でメタノール洗浄し、乾燥した。同様に、酸性基置換を持つ色素としてシスービス((4,4 'ージカルボン酸)2,2 ービピリジン)ージシアネートルテニウム(N3)をそれぞれ5×1 0 ⁻⁴ Mでエタノールに溶解して調製した溶液中に、上記のチタニアナノチューブ膜を浸漬し、80℃において12時間放置した後、アルゴン雰囲気下でメタノール洗浄し、乾燥した。

対極として、ITO付き基板上に、スパッタリング法により厚さ 1 0 μmの白金膜を付けたものを用いて、また電解質として、ヨウ素 0 3 8 g とヨウ化カリウム 2 . 4 9 g との混合物を、プロピレンカーボネート 2 5 重量%と炭酸エチレン 7 5 重量%との混合物 3 0 g に溶解したものを用いて、第 1 図に示すような構造の色素増感型太陽電池を作製した。

比較例

10

15 半導体層として通常の多孔質チタニア膜を用いた。チタニアペーストの作製は、荒川裕則「色素増感太陽電池の最新技術」(シーエムシー)p. 45-47(2001)を参考にして次のように行った。125 mlのチタンイソプロポキシドを750 mlの0.1 M硝酸水溶液に室温で撹拌しながらゆっくり滴下した。滴下が終了したら、80℃の恒温槽に20 移し、8時間撹拌する。これによって、白濁した半透明のゾル溶液が得られた。このゾル溶液を室温まで放冷し、ガラスフィルターでろ過した後、700 mlにメスアップした。得られたゾル溶液をオートクレーブへ移し、220℃で12時間水熱処理を行った後、1時間超音波処理により分散処理した。次いで、この溶液をエバポレーターにより40℃で濃縮し、チタニアの含有量が11重量%になるように調製した。この濃縮ゾル溶液に分子量が50万のPEOを添加し、遊星ボ

ールミルで均一に混合し、増粘したチタニアペーストを得た。

5

10

15

20

25

得られたチタニアペーストをスクリーン印刷法でフッ素ドープ導電性ガラス基板(シート抵抗 $30\Omega/\square$)上に $1cm \times 1cm$ の大きさで塗布した後、450 $\mathbb C$ に 30 分間保持し、チタニアペーストを導電性ガラス基板上で焼結し、多孔質チタニア膜を形成した。

そして、酸性置換基を持たない色素として5,10,15,20-テトラフェニルポルフィリン亜鉛錯体(ZnTPP)を5×10⁻⁴ Mでジメチルホルムアミドに溶解して調製した溶液中に、上記の多孔質チタニア膜を浸漬し、80℃において12時間放置した後、アルゴン雰囲気下でメタノール洗浄し、乾燥した。同様に、酸性置換基を持たない色素としてシスービス(2,2 'ービピリジン)ージシアネートルテニウム(N)を5×10⁻⁴ Mでジメチルホルムアミドに溶解して調製した溶液中に、上記の多孔質チタニア膜を浸漬し、80℃において12時間放置した後、アルゴン雰囲気下でメタノール洗浄し、乾燥した。

対極として、ITO付き基板上に、スパッタリング法により厚さ1

0μmの白金膜を付けたものを用いて、また電解質として、ヨウ素 0.38gとヨウ化カリウム 2.49gとの混合物を、プロピレンカーボネート 25重量%と炭酸エチレン75重量%との混合物 30gに溶解したものを用いて、第1図に示すものと同様な構造の色素増感型太陽電池を作製した。

上記のようにして作製した実施例および比較例の色素増感型太陽電池を擬似太陽光(AM1.5、100mW/cm²)を光源に用いて動作させた。その結果を表1に示す。なお、表1において、短絡電流とは、対向電極間を短絡して測定した電流を意味し、開放電圧とは、対向電極間をオープンにして発生した電圧を意味し、また光電変換効率は、次式で表される。

光電変換効率(%)

= (出力電気エネルギー/入射する太陽光エネルギー)×100

15

10

5

表 1

チタニア膜類	増感色素種	短絡電流 (mA)	開放電圧 (V)	光電変換効率 (%)
ナノチューブ	ZnTPP	5.0	0.6	-1.8
ナノチューブ	N	17. 2	0.75	10. 2
ナノチューブ	ZnTCPP	4.8	0. 5	1.44
ナノチューブ	N3	15.5	0.7	7. 6
多孔質	ZnTPP	0.1	0.3	0. 018
多孔質	N	0.12	0. 28	0.016
多孔質	ZnTCPP	4.7	0.6	1.7
多孔質	N3	14.5	0.69	7. 0

25

20

以上、この発明の一実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。

5

10

15

例えば、上述の実施形態において挙げた数値、構造、形状、材料、原料、プロセスなどはあくまでも例に過ぎず、必要に応じてこれらと異なる数値、構造、形状、材料、原料、プロセスなどを用いてもよい。以上説明したように、この発明によれば、チタニアナノチューブを含む半導体層を用い、そのチタニアナノチューブに増感色素を担持させることにより、増感色素として任意のものを使用することができるようになる。そして、酸性置換基の導入が必須でなくなることにより、増感色素の製造コストの低減を図ることができる。さらに、チタニアナノチューブは比表面積が非常に大きく、また、酸性置換基を有さない増感色素の使用により増感色素間の会合を抑えることができる。色素増感型光電変換装置の光電変換効率の向上を図ることができる。

請求の範囲

- 1. チタニアナノチューブを含む半導体層と、上記チタニアナノチューブに担持された増感色素と、を有することを特徴とする色素増感型光電変換装置。
 - 2. 上記増感色素として酸性置換基を有さない増感色素を用いたことを特徴とする請求の範囲1記載の色素増感型光電変換装置。
 - 3. 上記チタニアナノチューブに少なくとも2種類の増感色素を担持させたことを特徴とする請求の範囲1記載の色素増感型光電変換装置。

: · · ·)

- 10 4. 上記増感色素間が会合していないことを特徴とする請求の範囲 1 または 2 記載の色素増感型光電変換装置。
 - 5. 上記チタニアナノチューブの直径が 5 nm以上 8 0 nm以下であることを特徴とする請求の範囲 1 記載の色素増感型光電変換装置。
 - 6. 上記チタニアナノチューブの結晶型がアナターゼ型であることを特徴とする請求の範囲1記載の色素増感型光電変換装置。

15

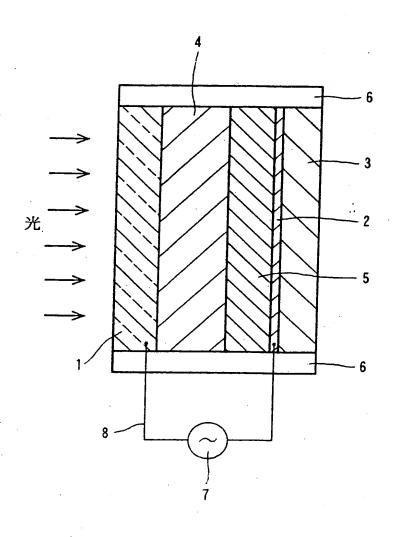
- 7. 互いに対向する一対の電極間に上記半導体層と電解質層とが設けられていることを特徴とする請求の範囲1記載の色素増感型光電変換装置。
- 8. 透明導電性基板とこの透明導電性基板の対極をなす導電性基板と 20 の間に上記半導体層と上記電解質層とが設けられ、光電変換によって 上記透明導電性基板と上記導電性基板との間に電気エネルギーを発生 することを特徴とする請求の範囲1記載の色素増感型光電変換装置。
 - 9. 上記透明導電性基板は透明導電膜を備えた透明基板であることを特徴とする請求の範囲8記載の色素増感型光電変換装置。
- 25 10. 色素増感型太陽電池として構成されていることを特徴とする請求の範囲8または9記載の色素増感型光電変換装置。

11. チタニアナノチューブを含む半導体層を用い、上記チタニアナノチューブに増感色素を担持させるようにしたことを特徴とする色素増感型光電変換装置の製造方法。

要約書

透明導電性基板と対極の導電性基板との間に半導体層と電解質層とが設けられる色素増感型光電変換装置において、半導体層としてチタニアナノチューブを含むものを用い、そのチタニアナノチューブに増感色素を担持させる。チタニアナノチューブとしては、好ましくは結晶型がアナターゼ型のものを用いる。この色素増感型光電変換装置を色素増感型太陽電池に用いる。

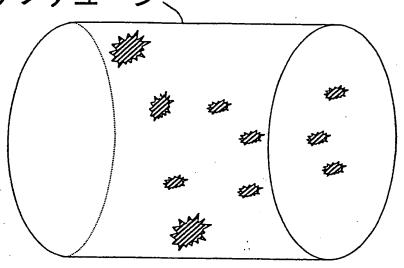
第1図



第2図

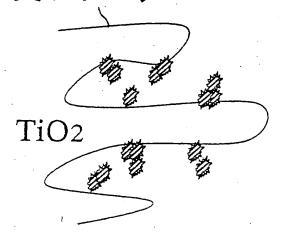
🐲 増感色素

チタニアナノチューブ



第3図

多孔質チタニア



符号の説明

1	透明導電性基板
2	導電膜
3	基板
4	チタニアナノチューブからなる半導体層
5	電解質層
6	ケース
7	アンメータ
8	電流回路

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.